(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 実用新案登録公報 (Y2) (11)実用新案登録番号

第2547366号

(45)発行日 平成9年(1997)9月10日

(24)登録日 平成9年(1997)5月16日

(51) Int.Cl.⁶ 識別記号 庁内整理番号 FΙ 技術表示箇所 F16K 31/126 F16K 31/126 Z 47/02 47/02 Α

請求項の数1(全 5 頁)

(21)出願番号 実願平4-76318 (73) 実用新案権者 000102511 エスエムシー株式会社 (22)出願日 平成4年(1992)11月5日 東京都港区新橋1丁目16番4号 (72)考案者 山田 博介 (65)公開番号 実開平6-40551 茨城県筑波郡谷和原村絹の台4-2-2 (43)公開日 平成6年(1994)5月31日 エスエムシー株式会社 筑波技術セン ター内 (72)考案者 海老沢 聡 茨城県筑波郡谷和原村絹の台4-2-2 エスエムシー株式会社 筑波技術セン ター内 (74)代理人 弁理士 千葉 剛宏 (外3名) 審査官 林 茂樹 (56)参考文献 実開 昭63-171807 (JP, U)

(54) 【考案の名称】 流体操作式開閉弁

(57) 【実用新案登録請求の範囲】

【請求項1】本体と、

前記本体の内部に画成され、被制御用流体が供給される 第1室内に配設された第1ダイヤフラムと、

前記本体の内部に画成され、操作用流体が供給される第 2室内に配設された第2ダイヤフラムと、

前記第1ダイヤフラムと第2ダイヤフラムとの間に配設 され、第1ダイヤフラムと第2ダイヤフラムとを一体的 に連結するステム部材と、

前記第1ダイヤフラムと前記第2ダイヤフラムとの間に 10 【産業上の利用分野】本考案は、操作用流体によって開 配設され、前記ステム部材をガイドするステムガイド と、

前記第1ダイヤフラムと前記第2ダイヤフラムとの間に 配設され、前記第1ダイヤフラムを前記第2室方向へと 付勢する弾性部材と、

前記第1室側に突出する前記ステム部材の先端部に固着 された弁体と、

前記弁体が前記第2室方向に変位することで着座する弁 座部と、

前記弁体と前記弁座部との間の流体通路を介して連通さ れる被制御用流体の導入口および導出口と、

を備えることを特徴とする流体操作式開閉弁。

【考案の詳細な説明】

[0001]

閉弁を操作し、純水あるいは薬液等の制御を行う流体操 作式開閉弁に関する。

[0002]

【従来の技術】半導体製造装置において、LSIの製造 の際に用いられる溶剤、洗浄液等が減圧弁を介して導入

され、洗浄の工程等で使用される。かかるLSIの製造 において、メモリ容量の増大化および処理速度の高速化 に対応すべく、使用される溶剤、洗浄液等には高純度の 品質が要求される。このため半導体製造装置では、例え ば減圧弁の本体中の液溜まり等の汚染要素をなくす必要 がある。

【0003】一方、半導体製造装置では、減圧弁だけで なく、操作用流体により弁の開閉を行う開閉弁も使用さ れる。

【0004】 このような開閉弁として実開昭63-17 10 【0011】 1807号公報に開示されたものがある。前記開閉弁 は、操作用流体の圧力を受圧するダイヤフラム(以下、 エア側ダイヤフラムと呼ぶ)と、作動流体の圧力を受圧 するダイヤフラム(以下、流体側ダイヤフラムと呼ぶ) との2枚のダイヤフラムを有し、流体側ダイヤフラムを 介して弁体を操作し、作動流体の通路の開閉を行ってい る。弁体は、前記通路側の室内に配設されたスプリング によってエア側ダイヤフラムの方向に付勢されている。 なお、作動流体に過大な圧力が生じた場合には、その圧 力を2枚の該ダイヤフラム間より外部に放出するため、 ステムと流体側ダイヤフラムとが離間して孔部を開口 し、前記圧力を外部へ放出する構成となっている。 [00051

【考案が解決しようとする課題】ところで、このような 開閉弁では、弁体が流体側ダイヤフラムと分離している ため、操作用流体の圧力に対する該ダイヤフラムの動作 の追随性が悪く、弁の開閉を適確に行うことができない だけでなく、作動流体を所望の圧力に制御することも困 難となる不具合がある。

【0006】また、弁の急激な開閉により、水撃が発生 30 する場合がある。この水撃により機器あるいは配管から 発塵を生じるおそれがある。

【0007】また、弁体を付勢するスプリングが作動流 体と接触する構成になっているため、錆等の不純物が混 入するおそれがある。

【0008】よって、半導体製造装置、特にプロセス装 置に用いられる開閉弁としては不適当である。

【0009】本考案は、以上の不都合を解消するために なされたものであって、応答特性がすぐれ、且つ、水撃 ない流体操作式開閉弁を提供することを目的とする。 [0010]

【課題を解決するための手段】前記の目的を達成するた めに、本考案は、本体と、前記本体の内部に画成され、 被制御用流体が供給される第1室内に配設された第1ダ イヤフラムと、前記本体の内部に画成され、操作用流体 が供給される第2室内に配設された第2ダイヤフラム と、前記第1ダイヤフラムと第2ダイヤフラムとの間に 配設され、第1ダイヤフラムと第2ダイヤフラムとを一 体的に連結するステム部材と、前記第1ダイヤフラムと 50 摺動自在に嵌挿される孔部40を有する環状突部42が

前記第2ダイヤフラムとの間に配設され、前記ステム部 材をガイドするステムガイドと、前記第1ダイヤフラム と前記第2ダイヤフラムとの間に配設され、前記第1ダ イヤフラムを前記第2室方向へと付勢する弾性部材と、 前記第1室側に突出する前記ステム部材の先端部に固着 された弁体と、前記弁体が前記第2室方向に変位すると とで着座する弁座部と、前記弁体と前記弁座部との間の 流体通路を介して連通される被制御用流体の導入口およ び導出口と、を備えることを特徴とする。

【作用】以上のように構成された流体操作式開閉弁にお いて、第2室内に供給された操作用流体により第2ダイ ヤフラム、ステム部材、第1ダイヤフラムを介して弁体 が弾性部材の弾発力に抗して弁座部から離間し、被制御 用流体の導入口および導出口間が所定の開度で連通す る。この場合、前記被制御用流体の圧力によって第1ダ イヤフラムが押圧されるが、この圧力は操作用流体の圧 力の方向と反対方向であるため、水撃による急激な圧力 の変動が生じても弁体の過大変位は抑制される。また、 20 被制御用流体の圧力と操作用流体の圧力とは均衡し、弁 体と弁座部との離間距離が一定となり、所望の圧力が得 られる。一方、第2室内から操作用流体を排出すると、 弾性部材の弾発力により弁体が弁座部に着座して被制御 用流体の供給が停止する。

【0012】なお、第1ダイヤフラムと第2ダイヤフラ ムとの間にステム部材と弾性部材が配設され被制御用流 体と接触することがないため、作動中に液溜まりの発生 することがなく、また、摺動による発塵も生じない。 [0013]

【実施例】以下、本考案に係る流体操作式開閉弁につい て好適な実施例を挙げ、添付の図面を参照しながら説明 する。

【0014】図1は本考案に係る実施例の流体操作式開 閉弁の縦断面図である。

【0015】図1において、参照符号10は、流体操作 式開閉弁を示す。前記流体操作式開閉弁10は、基本的 には、弁本体12とステムガイド14と蓋部16とから 構成されている。

【0016】前記弁本体12の側壁部には、純水、溶剤 を好適に抑制し、しかも、被制御用流体を汚染すること 40 等の流体が導入される導入口18が画成された導入部2 ○が連結される。前記導入□18より導入された流体は 通路を介して弁室22に至る。一方、前記弁室22の上 部には、弁本体12に画成された孔部24が連通する。 この孔部24には、下方向より弁体26が着座する弁座 部28が設けられる。前記孔部24は、その上部に画成 された第1室30を介して導出口32に連通する。

> 【0017】前記弁本体12の上部に装着されたステム ガイド14には、弁スプリング34が配設される凹部3 6が形成され、前記凹部36の中央部に、ステム38が

5

形成されている。

【0018】なお、この環状突部42の上端部にステム 38の段差44が当接することで、ステム38の移動範 囲が制限される。

【0019】前記ステム38の下端部には弁体26が固 着され、前記弁体26の上部に第1ダイヤフラム46が 固着され、上端部に第2ダイヤフラム48が固着され

【0020】前記第1ダイヤフラム46の上方には、ダ イヤフラム受け50がシール部材52と共にステム38 10 れた場合に、初期応答の遅れ(T)が生じ、操作用流体 に固着されている。

【0021】なお、第1および第2ダイヤフラム46、 48間の空間部は、ステムガイド14に画成した通路5 4、56を介して外部に連通している。

【0022】前記第1ダイヤフラム46は、内周部位が 肉厚で半径方向に向かって徐々に薄く形成され、その外 周部位が第1室30の側壁に固着されている。

【0023】前記第2ダイヤフラム48は前記ステムガ イド14の上部に固着されており、前記蓋部16の第2 体が供給される通路60が連通する。

【0024】本実施例の流体操作式開閉弁10は、以上 のように構成されるものであり、次にその動作について 説明する。

【0025】先ず、操作用流体を蓋部16に画成された 通路60より第2室58に導入する。この時の操作用流 体の圧力は、弁スプリング34の弾発力に抗して第1お よび第2ダイヤフラム46、48を変形させ、弁体26 を弁座部28から離間させる(図2参照)。

【0026】そして、導入口18から供給された流体 は、弁体26と弁座部28との間隙を通り、減圧されて 第1室30を介して導出口32より排出される。この場 合、第1室30に流入した流体は、第1ダイヤフラム4 6を変形させ、第2ダイヤフラム48を上昇させようと する。この圧力と操作用流体の圧力とがいわゆるフィー ドバックされることで均衡し、所定の圧力の流体を得る ことができる。

【0027】なお、本実施例の流体操作式開閉弁10 は、このようなフィードバック制御を利用して、操作用 流体圧力を調整し、排出流体圧力を制御する減圧機能付 40 開閉弁として使用することもできる。

【0028】ととで、図3は、本実施例の流体操作式開 閉弁10の操作用流体の圧力(P1)と排出される流体 の圧力(P2)の動作特性を示す図である。この場合、 操作用流体の圧力に対して極めてよく比例した排出流体 の圧力を得ることができる。しかも、第1ダイヤフラム 46に加わる圧力の方向は、第2ダイヤフラム48に加 わる操作用流体の圧力の方向と反対方向であるため、弁 開閉時に生じる水撃の圧力が抑制され、従って、弁体2 6は、穏やかに変位するととになる。そして、開弁、閉 50 【図面の簡単な説明】

弁時には、排出流体に脈動による圧力の変動も生じな い。また、操作用流体の供給、排出量をスピードコント ローラ等により調整するととで、配管条件等が変わって も効果的に前記の特性を設定することができる。

【0029】なお、図4は、比較例として、第2ダイヤ フラム48を図1の上方向に変位させることで弁体26 を開閉するように構成した場合の操作用流体の圧力(P 1)と排出される流体の圧力(P2)の動作特性を示す 図である。この例では、図の如く、操作用流体が導入さ の圧力(P1)に対して排出流体の圧力(P2)の追随 性が悪い。また、開弁、閉弁時には、操作用流体の圧力 の方向と排出流体の圧力の方向とが同一方向となるた め、弁体26の移動速度が加速され、水撃による脈動 (P3)が生じている。

【0030】以上のように、本実施例の流体操作式開閉 弁10では、操作用流体の圧力(P1)を制御して所望 の圧力(P2)の排出流体を得ることができる。しか も、水撃の影響を抑制し、安定した流体圧特性を得ると 室58を画成している。前記第2室58には、操作用流 20 とができるとともに、衝撃が生じないので、それによる 騒音の発生や発塵もない。また、前記第1ダイヤフラム 46により流体の進入が阻止されているため、ダイヤフ ラム受け50とステム38の摺動部位と流体が接触する ことがなく、従って、塵埃等が流体に混入することがな い。さらに、前記第1室30に弁スプリング34等の構 成物が存在しないため、液溜まりが生ずることを阻止で き、これによって流体が汚染される不都合を回避でき る。

[0031]

30 【考案の効果】本考案に係る流体操作式開閉弁によれ ば、以下の効果を奏するものである。

【0032】第1ダイヤフラムと第2ダイヤフラムとが 弁体と一体となったステムに固着されることにより、第 2 ダイヤフラムが操作用流体の圧力を受圧すると同時に 弁体が弁座部より離間し、流体が所定圧で導出される。 この場合、操作用流体の圧力の変化に弁体が迅速に追随 して変位し、所望の圧力の流体を得ることができる。

【0033】さらに、弁体の開閉時の水撃の発生を抑制 できるため、発塵を防止できる。

【0034】ととで、弾性部材およびステム等が前記第 1ダイヤフラムにより流体から隔離されているため、流 体中に塵埃等が混入することを防止し、溶剤、純水の汚 染要素を減少させることができる。また、溶剤、純水等 の液溜まりをなくして、不純物の滞留を防止できる。

【0035】とれにより、例えば、半導体製造装置、特 にプロセス装置に用いられる減圧弁に代え、本考案の流 体操作式開閉弁を使用することで、メモリ容量の増大化 や処理速度の高速化の要求に対応したLSIを製造する 際の生産効率の向上を図ることができる。

,

【図1】本考案の実施例に係る流体操作式開閉弁の縦断 面図である。

【図2】図1に示す流体操作式開閉弁の開弁状態を示す 縦断面図である。

【図3】比較例の流体操作式開閉弁の動作特性を示す図である。

【図4】従来技術の開閉弁の動作特性を示す図である。 【符号の説明】

10…流体操作式開閉弁

12…弁本体

14…ステムガイド

* 16…蓋部

22…弁室

26…弁体

28…弁座部

30…第1室

34…弁スプリング

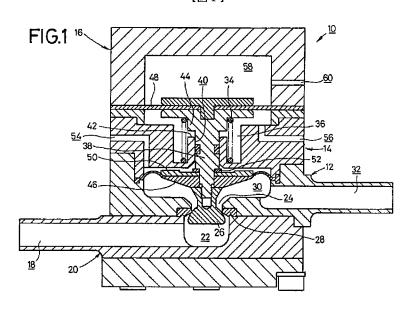
38…ステム

46…第1ダイヤフラム

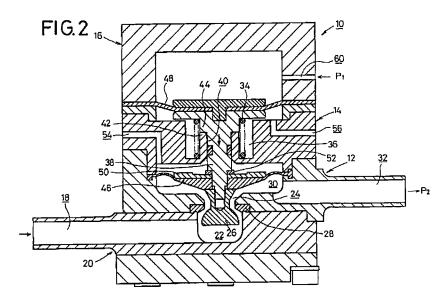
48…第2ダイヤフラム

10 58…第2室 * 60…通路

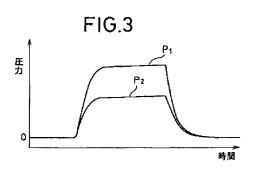
【図1】



【図2】



【図3】



【図4】

